

Краткие сообщения по физике № 12 1983

К ТЕОРИИ РЕЗОНАНСНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ВЫСОКОЧАСТОТ-
НЫМ ДОПЛЕРОНОМ

А. Ю. Романов, В. П. Селин

УДК 538.569

Выявлено влияние поверхностного рассеяния электронов на коэффициент прохождения через металлическую пластину высокочастотного доплерона.

В работе /1/ для проводников с частичной компенсацией электронов и дырок были изучены высокочастотные (ВЧ) доплероны. Такие волны возникают в условиях, когда их частота и волновой вектор не попадают в область сильного бесстолкновительного циклотронного затухания. ВЧ доплероны имеют круговую поляриза-

ция. При этом левополяризованный ВЧ доплерон с уменьшением частоты переходит в обычный доплерон с линейной зависимостью частоты от волнового вектора. Напротив, в области частот, близких к циклотронной, частота левополяризованного доплерона является квадратичной функцией волнового вектора. Спектр правополяризованного ВЧ доплерона в коротковолновой области линейно зависит от волнового вектора, а в длинноволновой области переходит в спектр геликона, обусловленного дырочными носителями тока.

В работе /2/ было показано, что для экспериментального исследования ВЧ доплеронов целесообразно изучать прохождение электромагнитных волн через металл. Там был получен коэффициент прохождения электромагнитного излучения через металлическую пластину в модели зеркального отражения электронов проводимости от поверхности металла, в связи с чем ширины резонансного пропускания, да и сами возможности резонансов определялись только рассеянием электронов в объеме металла.

В настоящем сообщении мы выясним роль диффузного рассеяния в резонансах прохождения излучения. Для наших целей полезен подход работы В. И. Окулова и В. В. Устинова /3/, которые, в частности, для модели металла с параболической поверхностью Ферми электронов получили следующую формулу для импеданса пластины при ее антисимметричном возбуждении:

$$Z(a) = Z_0 \frac{(\alpha_1 s_1^{(a)}/x_1) + (\alpha_2 s_2^{(a)}/x_2) + \eta x_0 \rho s_1^{(a)} s_2^{(a)}/x_1 x_2}{1 + \eta x_0 (\alpha_2 s_1^{(a)}/x_1 + \alpha_1 s_2^{(a)}/x_2)}. \quad (I)$$

Здесь $\eta = \pm 1$ соответствует правой и левой поляризации излучения с частотой ω , $\rho = p/(2 - p)$, p - коэффициент диффузности рассеяния, $Z_0 = 2\pi\omega d/c^2$, $\alpha_1 = (x^2 - x_1^2)/(x_2^2 - x_1^2)$, $\alpha_2 = (x^2 - x_2^2)/(x_1^2 - x_2^2)$; $s_j^{(a)} = -itg(Lx_j/2d)$, L - толщина металлической пластины, c - скорость света, $d = v/\Omega$ определяет смещение электронов вдоль направления постоянного магнитного поля за период циклотронного вращения с частотой $\Omega = eB/mc$, $e = |e|$ - абсолютная величина заряда электрона, $x = 1 + \eta(\omega + i\nu)/\Omega$, ν - частота объемных столкновений; наконец x_1 и x_2 - решения дисперсионного уравнения

$$x_{1,2}^2 = \frac{1}{2} (x^2 + \eta \xi / \chi) \left\{ 1 \mp \sqrt{1 + \frac{4\eta \xi x (1 - x/\chi)}{(x^2 + \eta \xi / \chi)^2}} \right\}.$$

При этом параметр $\xi = 4\pi\omega\sigma_H d^2/c^2$, где $\sigma_H = evc/v$ определяется напряженностью магнитного поля \vec{v} и плотностью носителей (электронов). Наконец, параметр $\chi = (n_e/n_h)x_n^2$ характеризует вклад в комплексную проводимость дырок с плотностью n_h и $x_n^2 = 1 - \eta(\omega + i\nu_h)/\Omega_h$, где Ω_h и ν_h - циклотронная частота и частота столкновений дырок. При этом вклад дырок в проводимость принимается локальным, что отвечает возможности пренебрежения эффектами пространственной дисперсии, обусловленными дырочными носителями. Для этого будем считать выполненным неравенство

$$(\omega - \eta\Omega_h)^2 \gg k^2 v_h^2 \equiv (v_h^2/v^2)(\Omega + \eta\omega)[(1 - \chi)\Omega + \eta\omega],$$

что возможно при $n_e \leq n_h$.

Совершенно аналогично работе /3/ проводится вывод импеданса для симметричного возбуждения пластины, который отличается от (I) заменой $\alpha_3^{(a)}$ на величину $\alpha_3^{(s)} = i \operatorname{ctg}(Lx_3/2d)$. Значие импедансов как симметричного, так и антисимметричного возбуждения необходимо для определения коэффициента прохождения - отношения амплитуд прошедшей и падающей волн $T = (c/2\pi)(Z^{(s)} - Z^{(a)})$, для которого имеем

$$\begin{aligned} T = & \frac{2\omega d}{c} \left\{ 1 \frac{\alpha_1}{x_1} \left(1 + \frac{\rho^2 x_2^2}{x_1^2} \right) \operatorname{cosec} \frac{x_1 L}{d} + 1 \frac{\alpha_2}{x_2} \left(1 + \frac{\rho^2 x_2^2}{x_1^2} \right) \operatorname{cosec} \frac{x_2 L}{d} - \right. \\ & \left. - 2 \frac{\eta\rho x}{x_1 x_2} \left[\alpha_1 \operatorname{cosec} \frac{x_1 L}{d} \operatorname{ctg} \frac{x_2 L}{d} + \alpha_2 \operatorname{cosec} \frac{x_2 L}{d} \operatorname{ctg} \frac{x_1 L}{d} \right] \right\} \times \\ & \times \left\{ 1 + 2i\eta\rho x \left[\frac{\alpha_2}{x_1} \operatorname{ctg} \frac{x_1 L}{d} + \frac{\alpha_1}{x_2} \operatorname{ctg} \frac{x_2 L}{d} \right] + \rho^2 x^2 \left[\frac{\alpha_2^2}{x_1^2} + \frac{\alpha_1^2}{x_2^2} + \right. \right. \\ & \left. \left. + 2 \frac{\alpha_1 \alpha_2}{x_1 x_2} \left(\operatorname{cosec} \frac{x_1 L}{d} \operatorname{cosec} \frac{x_2 L}{d} - \operatorname{ctg} \frac{x_1 L}{d} \operatorname{ctg} \frac{x_2 L}{d} \right) \right] \right\}^{-1}. \end{aligned}$$

В пределе $\xi \gg x^2 \chi$, $x > \chi$, $x_1^2 = x(x - \chi)$ описывает ВЧ доплерон, а $x_2^2 = \eta \xi / \chi$ может отвечать скинновой компоненте поля, например, при малости мнимой части $\epsilon_n^* \in \text{Re } x_2^2 < 0$. Тогда при выполнении условия $\xi L^2 \gg |\chi| d^2$ для коэффициента прохождения получаем

$$T = \frac{2\omega d \alpha_1}{c x_1} \left\{ \left[1 + \rho^2 x^2 / x_1^2 \right] \sin \frac{x_1 L}{d} + 2i \eta \rho \frac{x}{x_1} \cos \frac{x_1 L}{d} \right\}^{-1}.$$

В явном виде модуль коэффициента прохождения излучения левой поляризации ($\eta = -1$) определяется формулой:

$$|T| = \frac{2\omega d}{c} \frac{\chi^2}{\xi} \sqrt{\frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega}} \left\{ \left[1 - \rho^2 \frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega} \right]^2 \times \right. \\ \times \sin^2 \left[\frac{L \sqrt{\Omega - \omega}}{d} \sqrt{(1 - \chi)\Omega - \omega} \right] + \left[1 + \rho^2 \frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega} \right] \text{sh} \left[\frac{L}{2l} \times \right. \\ \times \left. \frac{(2 - \chi)\Omega - 2\omega}{\sqrt{(\Omega - \omega)[(1 - \chi)\Omega - \omega]}} \right] + 2\rho \sqrt{\frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega}} \times \\ \left. \times \text{ch} \left[\frac{L}{2l} \frac{(2 - \chi)\Omega - 2\omega}{\sqrt{(\Omega - \omega)[(1 - \chi)\Omega - \omega]}} \right] \right\}^{-1/2}.$$

Здесь и ниже пренебрегается частотой столкновения дырок. В соответствии с работой /2/ ярко выраженный резонанс прохождения возможен только в условиях малости толщины пластины по сравнению с длиной свободного пробега электрона 1

$$\left| \frac{L}{2l} \frac{(2 - \chi)\Omega - 2\omega}{(\Omega - \omega)[(1 - \chi)\Omega - \omega]} \right| \ll 1,$$

когда формула (10) имеет следующий вид:

$$|T| = \frac{2\omega d}{c} \frac{\chi^2}{\xi} \sqrt{\frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega}} \left\{ \left[1 - \rho^2 \frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega} \right]^2 \times \right. \\ \times \sin^2 \left[\frac{L}{d} \sqrt{(\Omega - \omega)[(1 - \chi)\Omega - \omega]} \right] + \left[1 + \rho^2 \frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega} \right] \times$$

$$\times \frac{L}{2l} \frac{(2 - \chi)\Omega - 2\omega}{\sqrt{(\Omega - \omega)[(1 - \chi)\Omega - \omega]}} + 2\rho \sqrt{\frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega}} \Big|^{-1/2}. \quad (3)$$

Резонансное прохождение возникает для частот или магнитных полей, удовлетворяющих дисперсионному уравнению: $(\Omega - \omega)[(1 - \chi)\Omega - \omega] = (\pi n d \Omega / L)^2$, n - целое число. Вблизи частот резонансного прохождения при выполнении условия $(\rho L(\Omega - \omega) / \pi n d \Omega)^2 \cong \rho^2 (\Omega - \omega) / [(1 - \chi)\Omega - \omega] \ll 1$ формула (12) принимает вид

$$|T_n| = \frac{2\omega d}{c} \frac{\chi^2}{\xi} \sqrt{\frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega}} \left\{ \left[\frac{L}{d\Omega} \sqrt{(\Omega - \omega)[(1 - \chi)\Omega - \omega]} - \pi n \right]^2 + \left[\frac{\Omega - \omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega} \right] \left[\frac{L}{2l} \frac{(2 - \chi)\Omega - 2\omega}{\Omega - \omega} + 2\rho \right]^2 \right\}^{-1/2}.$$

При этом уширение резонанса растет с ростом ρ . Противоположная ситуация имеет место при условии $\rho^2 \gg [(\chi)\Omega - \omega] / (\Omega - \omega)$, когда

$$|T_n| = \frac{2\omega d}{c} \frac{\chi^2}{\xi \rho^2} \sqrt{\frac{(1 - \chi)\Omega - \omega}{\Omega - \omega}} \left\{ \left[\frac{L}{d\Omega} \sqrt{(\Omega - \omega)[(1 - \chi)\Omega - \omega]} - \pi n \right]^2 + \frac{(1 - \chi)\Omega - \omega}{\Omega - \omega} \left[\frac{L}{2l} \frac{(2 - \chi)\Omega - 2\omega}{(1 - \chi)\Omega - \omega} + \frac{2}{\rho} \right]^2 \right\}^{-1/2},$$

и когда уширение резонанса убывает с ростом ρ . Однако при этом по закону ρ^{-2} убывает сам коэффициент прохождения.

Поступила в редакцию

16 июня 1983 г.

Л и т е р а т у р а

1. А. Ю. Романов, ФММ, 55, 1070, (1983).
2. А. Ю. Романов, В. П. Силин, ФММ, 56, 639 (1983).
3. В. И. Окулов, В. В. Устинов, ФММ, 56, 421 (1983).